стойкости до 1,5 раз в солевой (3 %-ный раствор NaCl) и до 2,7 раз в сернокислой (1 М H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) средах по сравнению со сталью Ст3, что обусловлено твердорастворным, зернограничным и деформационным механизмами упрочнения, и которые могут быть рекомендованы для упрочнения рабочих конструкций, узлов и механизмов, применяемых на предприятиях машиностроения, деревообрабатывающей и горнодобывающей промышленности.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Combined Vacuum-Arc Deposition of Protective Coatings on Basis of Transition Metals Nitrides Solid Solution / V. V. Uglov [et al.] // Proceedings of 9th Internat. Conf. on modification of materials with particle beams and plasma flows, Tomsk, Russia, 21–26 September 2008. – Tomsk, 2008. – P. 491–494.

2. Барковская, М. М. Влияние величины тока горения хромового катода на элементный и фазовый состав покрытий на основе системы Ti-Cr-N / М. М. Барковская, В. В. Ходасевич // Современные методы и технологии создания и обработки материалов. Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки: в 3 кн. / редкол.: С. А. Астапчик (гл. ред.) [и др.]. – Минск: ФТИ НАН Беларуси 2014. – Кн. 2. – С. 55–64.

3. Thermal stability of nitride coatings formed by ion-plasma deposition / V. V. Uglov [et al.] // Vacuum. – 2007. – Vol. 81. – P. 1345–1347.

4. Термостабильность поверхностных слоев нитридов титана и хрома, сформированных конденсацией с ионной бомбардировкой на твердом сплаве Т5К10 / А. К. Кулешов [и др.]. // Перспективные материалы. – 2009. – № 2. – С. 68–73.

5. Барковская, М. М. Состав и коррозионная стойкость покрытий на основе нитридов титана и хрома / М. М. Барковская, В. В. Углов, В. В. Ходасевич // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2011. – № 4. – С. 104–109.

## ФУНКЦИИ ГРИНА РЕЛЯТИВИСТСКИХ ДВУХЧАСТИЧНЫХ КВАЗИПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В СЛУЧАЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЭНЕРГИИ

### А. В. Бужан, В. Н. Капшай

Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», г. Гомель, Республика Беларусь

Двухчастичная система может быть описана в рамках квазипотенциального подхода квантовой теории поля. Релятивистские уравнения для сферически симметричных волновых функций, описывающие состояния рассеяния системы двух частиц равной массы *m* в импульсном представлении могут быть записаны в виде [1]:

#### СЕКЦИЯ 3

Современные научные исследования в области физико-математических и технических дисциплин

$$\Psi_{(j)}(\chi_q,\chi) = \frac{\pi}{2m} \delta(\chi_q - \chi) - \frac{2m}{\pi} G_{(j)}(\chi_q,\chi) \int_0^\infty d\chi' V(\chi_q,\chi') \Psi_{(j)}(\chi_q,\chi'), \quad (1)$$

где индекс j = 1,4 соответствует одному из вариантов квазипотенциального подхода: j = 1 (j = 3) – уравнение Логунова–Тавхелидзе (модифицированное), j = 2 (j = 4) – уравнение Кадышевского (модифицированное). В данной работе рассмотрим случай j = 2, в котором функция Грина уравнения Кадышевского в импульсном представлении имеет вид [2]

$$G_{(2)}(\chi_q,\chi) = \frac{1}{m^2 \operatorname{ch} \chi (2\operatorname{ch} \chi - 2\operatorname{ch} \chi_q - i0)},$$
(2)

в котором  $2m \operatorname{ch} \chi_q = 2E_q$  есть энергия двухчастичной системы.

Волновые функции, функции Грина и потенциалы в импульсном представлении связаны с соответствующими величинами в релятивистском конфигурационном представлении следующими соотношениями:

$$\psi_{(j)}(\chi_q, r) = \int_0^{+\infty} d\chi \sin(\chi m r) \Psi_{(j)}(\chi_q, \chi), \qquad (3)$$

$$G_{(j)}(\chi_q, r, r') = -\frac{2m}{\pi} \int_0^{+\infty} d\chi \sin(\chi m r) G_{(j)}(\chi_q, \chi) \sin(\chi m r') =$$
  
=  $-\frac{m}{\pi} \left[ \int_0^{+\infty} d\chi \cos(\chi m (r - r')) G_{(j)}(\chi_q, \chi) - \int_0^{+\infty} d\chi \cos(\chi m (r + r')) G_{(j)}(\chi_q, \chi) \right], (4)$ 

$$V(\chi,\chi') = \int_{0}^{+\infty} dr \sin(\chi mr) V(r) \sin(\chi' mr).$$
(5)

После перехода к релятивистскому конфигурационному представлению, полученные интегральные уравнения могут быть решены численно. Например, для поиска резонансов сечений рассеяния может быть использован метод комплекс-скейлинга [3], в котором выполняется комплексный поворот переменной интегрирования и значения энергий, а значит и быстроты  $\chi_q$  также становятся комплексными.

Отметим, что функция Грина (2) является периодической в комплексной плоскости по переменной  $\chi_q$  с периодом  $2i\pi$ . Поэтому функцию Грина достаточно рассмотреть в области

$$0 \le \operatorname{Im} \chi_q < 2\pi \,. \tag{6}$$

Для нахождения функции Грина  $G_{(2)}(\chi_q, r, r')$  в релятивистском конфигурационном представлении воспользуемся свойством периодичности функции Грина (2) также по переменной  $\chi$ .



Рисунок 1 – Полюса функции Грина (2) при  $\operatorname{Re} \chi_q > 0$ ,  $\operatorname{Im} \chi_q > 0$ 

Для того чтобы вычислить интегралы в выражении (4), рассмотрим интеграл от функции  $\cos(\chi mr)G_{(2)}(\chi_q,\chi)$ , по замкнутому контуру *C*, имеющему вид прямоугольника со сторонами  $2Ru2\pi$  (см. рисунок 1). Для интеграла справедливо соотношение

$$\int_{c} d\chi \cos(\chi mr) G_{(2)}(\chi_{q}, \chi) = 
\int_{-R}^{+R} d\chi \cos(\chi mr) G_{(2)}(\chi_{q}, \chi) + \int_{+R}^{+R+2i\pi} d\chi \cos(\chi mr) G_{(2)}(\chi_{q}, \chi) + 
\int_{-R}^{-R+2i\pi} d\chi \cos(\chi mr) G_{(2)}(\chi_{q}, \chi) + \int_{-R+2i\pi}^{-R} d\chi \cos(\chi mr) G_{(2)}(\chi_{q}, \chi).$$
(7)

Третье слагаемое можно представить в виде

$$\int_{+R+2i\pi}^{-R+2i\pi} d\chi \cos(mr \operatorname{Re} \chi + 2i\pi mr) G_{(2)}(\chi_q, \operatorname{Re} \chi + 2i\pi) = -\operatorname{ch}(2\pi mr) \int_{-R}^{+R} d\chi \cos(\chi mr) G_{(2)}(\chi_q, \chi).$$
(8)

При переходе к пределу  $R \to \infty$  второе и четвёртое слагаемые выражения (7) стремятся к нулю. С учётом (8) интеграл по замкнутому контуру связан с искомыми интегралами выражения (4) соотношением

$$\oint_{c} d\chi \cos(\chi mr) G_{(2)}(\chi_{q},\chi) = (1 - \operatorname{ch}(2\pi mr)) 2 \int_{0}^{+\infty} d\chi \cos(\chi mr) G_{(2)}(\chi_{q},\chi).$$
(9)

Левую часть этого равенства можно вычислить, используя теорему о вычетах:

$$\oint_{c} d\chi \cos(\chi mr) G_{(2)}(\chi_{q}, \chi) = 2\pi i \sum_{n} \operatorname{Res} \left[ \cos(\chi_{n} mr) G_{(2)}(\chi_{q}, \chi_{n}) \right].$$
(10)

После преобразований интегралы выражения (4) могут быть записаны в виде

$$\int_{0}^{+\infty} d\chi \cos(\chi mr) G_{(2)}(\chi_q, \chi) = -\frac{\pi i}{2 \operatorname{sh}^2(\pi mr)} \sum_n \operatorname{Res}[\cos(\chi_n mr) G_{(2)}(\chi_q, \chi_n)], \quad (11)$$

где быстроты  $\chi_q$  удовлетворяют условию (6).

Окончательно получим следующее выражение для функции Грина в релятивистском конфигурационном представлении

Современные научные исследования в области физико-математических и технических дисциплин

$$G_{(2)}(\chi_q, r, r') = G_{(2)}(\chi_q, r_d) - G_{(2)}(\chi_q, r_u),$$
(12)

$$G_{(2)}(\chi_q, r) = -\frac{m}{\pi} \int_0^\infty d\chi \cos(\chi m r) G_{(2)}(\chi_q, \chi) = im \frac{\sum_n \operatorname{Res} \left[ \cos(\chi_n m r) G_{(2)}(\chi_q, \chi_n) \right]}{2 \operatorname{sh}^2(\pi m r)}.$$
(13)

В уравнении (12) введена замена  $r_d = r - r', r_u = r + r'.$ 

Конечное выражение для функции Грина уравнения Кадышевского (j = 2) может быть найдено путём вычисления вычетов в полюсах первого порядка и имеет следующий вид:

$$G_{(2)}(\chi_q, r) = \frac{1}{4m \operatorname{ch} \chi_q \operatorname{ch} \left(\frac{\pi m r}{2}\right)} - \frac{i}{m \operatorname{sh}(2\chi_q)} \frac{\operatorname{sh}[(\pi + i\chi_q)mr]}{\operatorname{sh}(\pi m r)}.$$
 (14)

В случае действительных отрицательных значений быстроты функция Грина может быть представлена как

$$G'_{(2)}(\chi_q, r) = \frac{1}{4m\operatorname{ch}\chi_q \operatorname{ch}\left(\frac{\pi mr}{2}\right)} - \frac{i}{m\operatorname{sh}(2\chi_q)} \frac{\operatorname{sh}\left[\left(-\pi + i\chi_q\right)mr\right]}{\operatorname{sh}(\pi mr)}.$$
 (15)

Функция (15) отличается от известной функции (14) знаком перед  $\pi$ . В этом особом случае функция Грина оказывается чётной по отношению к вещественной части быстроты  $\chi_a$ .

Продолжая рассмотрение полюсов функции Грина (2), заметим, что при чисто мнимых значениях  $\chi_q$  может происходить вырождение полюсов функции

Грина. Так, например, при значениях быстроты  $\chi_q = i \frac{\pi}{2}, \chi_q = i \frac{3\pi}{2}$  происходит вырождение полюсов функции Грина уравнения Кадышевского и число полюсов уменьшается вдвое, а их порядок увеличивается до второго.

Рассматриваемая функция Грина в таком случае равна

$$G_{(2)}\left(i\frac{\pi}{2},r\right) = G'_{(2)}\left(i\frac{3\pi}{2},r\right) = -\frac{r}{4ch\left(\frac{\pi mr}{2}\right)}.$$
 (16)

При значении быстроты  $\chi_q = i\pi$  происходит частичное вырождение полюсов функции Грина (2), а сама функция принимает следующий вид

$$G_{(2)}(i\pi,r) = \frac{1}{2m\operatorname{sh}(\pi m r)} \left[ mr - \operatorname{sh}\left(\frac{\pi m r}{2}\right) \right].$$
(17)

Функции (16) и (17) также могут быть получены путём раскрытия неопределённости вида (0/0) функции (14) при соответствующих значениях быстроты.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гришечкин, Ю. А. Метод комплексного поворота для двухчастичных уравнений в импульсном представлении и резонансные состояния / Ю. А. Гришечкин, М. С. Данильченко, В. Н. Капшай // Проблемы физики, математики и техники. – 2014. – № 3(20). – С. 21–25.

2. Kadyshevsky, V. G. Quasipotential type equation for there lativistics cattering amplitude / V. G. Kadyshevsky // Nucl. Phys. – 1968. – Vol. B6, № 1. – P. 125–148.

3. Lazauskas, R. Application of the complex scaling method in quantum scattering theory: habilitation thesis / R. Lazauskas. – Strasbourg, 2019. – 133 p.

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЩНОЙ МАТРИЦЫ СВЕТОДИОДОВ С ПОМОЩЬЮ РАДИАТОРА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

## В. И. Гладковский, В. В. Борушко

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет», г. Брест, Республика Беларусь

Рабочие параметры светодиодов в большой степени зависят от температуры. При возрастании температуры прямое напряжение p-n перехода светодиода уменьшается, что может приводить к ухудшению работоспособности и разрушению схемы. Перечисленные факторы приводят к необходимости установления жестких ограничений на рабочий диапазон температур светодиодных элементов, создания специальных цепей температурной защиты и совершенствования способов отвода тепла [1]. Объектом данного исследования являлась светодиодная матрица размерами 1,5·0,6 см<sup>2</sup>, расположенная на алюминиевой подложке. Для повышения эффективности охлаждения светодиодная матрица изначально помещалась в стеклянную трубку с прокачиваемой по ней насосом охлаждающей жидкостью, в качестве которой использовался этиловый спирт [2–5]. Цель работы заключалась в оценке возможности охлаждения рассматриваемой матрицы светодиодов с помощью воздушного радиатора и соответствующий расчёт.

Для проведения вычислений задаём следующие исходные данные:

 $\Theta_{\rm p} = 330 \ {\rm K} - {\rm средняя}$  температура основания радиатора;

Z = 31 – число ребер радиатора;

В = 0,025 м – размер радиатора поперёк рёбер;

Н = 0,03 м – высота ребра радиатора;

L = 0,085 м – размер радиатора вдоль ребра;

 $\delta = 0,0005$  м – толщина ребра;